

Комплементарная пара :

PNP - СВЧ-транзистор (Hihg Voltage Transistor и Lower Voltage Transistor) ,

NPN - СВЧ-транзистор (Hihg Voltage Transistor и Lower Voltage Transistor) ,

Параметры:

. Размер кристаллов:

Hihg Voltage Transistor – 0,5x0,5 мм

Lower Voltage Transistor – 0,5x0,5 мм

Hihg Voltage Transistor specs

N	Parametr	Conditions	Min	Max	Units
1	BVCEO	IC=1μA, IE=0.9nA	85		V
2	BVCBO	IC=1μA	100		V
3	BVEBO	IE=1μA	5,75		V
4	VBES	IC=50mA, IB=10mA		0,95	V
5	VCES	IC=50mA, IB=10mA		0,3	V
6	VBE ON	VCE=10V, IE=1μA	0,45		V
7	VBE ON	VCE=20V, IC=60mA	0,7	0,8	V
8	IEBO	VEB=4V		10	nA
9	ICEO	VCE=75V		30	nA
10	ICBO	VCB=80V		20	nA
11	ICES	VCE=80V, VBE=0		30	nA
12	HFE	VCB=5V. IC=10mA	30	150	
13	HFE	VCB=5V. IC=40mA	30	150	
14	HFE	VCB=5V. IC=70mA	30	150	
15	HFE	VCB=45V. IC=10mA	35	150	
16	HFE	VCB=45V. IC=40mA	35	150	
17	HFE	VCB=45V. IC=70mA	35	150	
18	Ft	IC=10mA-75mA	700		MHZ

Lower Voltage Transistor specs.

N	Parametr	Conditions	Min	Max	Units
1	BVCEO	IC=1μA, IE=0.9nA	30		V
2	BVCBO	IC=1μA	40		V
3	BVEBO	IE=1μA	5		V
4	VBES	IC=50mA, IB=10mA		0,95	V
5	VCES	IC=50mA, IB=10mA		0,3	V
6	VBE ON	VCE=10V, IE=1μA	0,45		V
7	IEBO	VEB=3V		10	nA
8	ICEO	VCE=25V		30	nA
9	ICBO	VCB=25V		20	nA
10	ICES	VCE=20V, VBE=0		30	nA
11	HFE	VCB=5V. IC=10mA	50	250	
12	HFE	VCB=5V. IC=40mA	50	250	
13	HFE	VCB=5V. IC=70mA	50	250	
14	Ft	IC=10mA-75mA	1000		MHZ

Результаты тестирования npn и pnp пары СВЧ-транзисторов (Hihg Voltage Transistor) в США:

Пробивное напряжение коллектора – база: 110 В,

Пробивное напряжение коллектора – эмиттер: 55-60 В,

Быстродействие: npn 27 нс (h₂₁₃=130-150)

pnp 12-15 нс (h₂₁₃=70-90)